

有機電界効果トランジスタ（有機FET）電極

p/n型半導体両特性同時に高移動度を実現した有機FET用電極

概要

本発明は、有機物質を活性材料として用いた電界効果トランジスタやエレクトロルミネセンス素子などの有機素子に用いる電極の形成方法に関するものです。

従来技術に比べて有機材料と電極の接触界面における電気抵抗（接触抵抗）を低減することが可能です。

また、素子としての **電子移動度/正孔移動度において、両特性同時に高い値を実現することが可能**です。

応用例

- 有機EL、有機レーザ用電極
- ウェアラブルデバイス等の有機半導体用電極

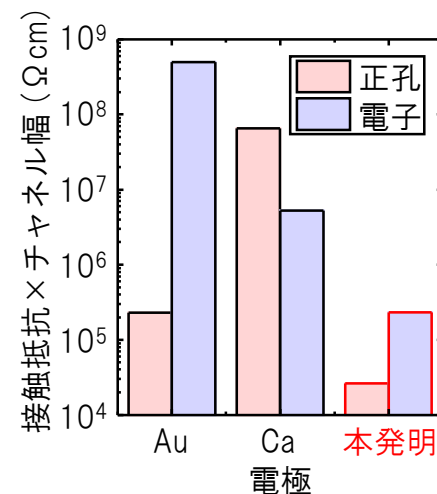
特許データシート

特許出願番号（整理番号）：WO2017/187885 (T15-204)

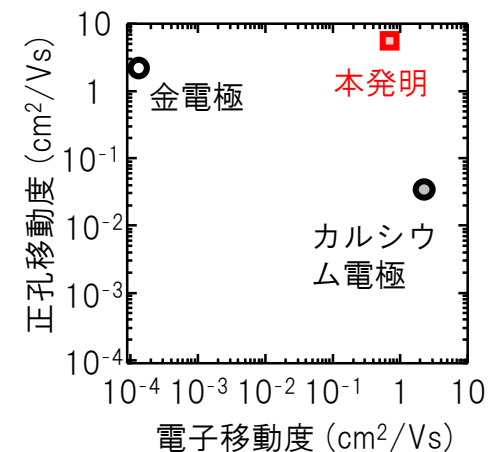
発明者： 谷垣 勝己、下谷 秀和、他

結果

■ トランジスタの接触抵抗
（有機半導体X）



■ 電子/正孔移動度
（有機半導体Y）



1種類の電極で従来技術より1~3桁の低減

正孔移動度 5.6 cm²/Vs
電子移動度 0.7 cm²/Vs

連絡先

株式会社 東北テクノアーチ

TEL 022-222-3049

FAX 022-222-3419

問い合わせは [こちら](#) からお願いします。